2SC2088

シリコンNPNエピタキシアル形トランジスタ(PCT方式
SILICON NPN EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS

TENTATIVE

昭和52年度発売予定

○ 低周波低雑音増幅用

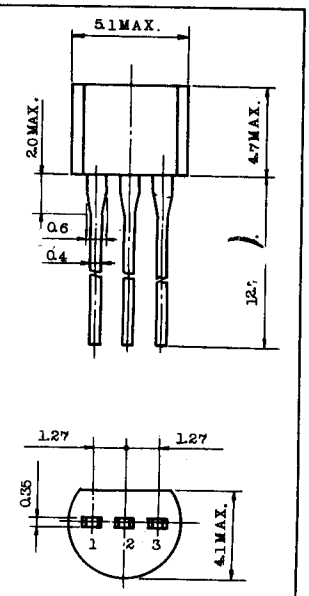
○ Low Noise Audio Amplifier Applications

- 高耐圧です。: V_{CEO} = 120V
- 雑音指数が小さい。NF=6dB (Max.)(Rg=10kΩ, f=10Hz)
- パルス性雑音が小さい。
- 電流増幅率が高い。: h_{FE} = 350 ~1200
- プリアンプおよびメインアップ初段増幅に適しています。
- High V_{CEO} · Low Noise · Low Pulse Noise
- High h_{FE}

最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	120	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	120	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	50	mA
エミッタ電流	I_E	-50	mA
コレクタ損失	P_C	300	mw
接合温度	T_j	125	℃
保存温度	Tstg	-55~ 125	℃

Unit in mm



1. EMITTER
2. COLLECTER
3. BASE

JEDEC	—
EIAJ	—
TOSHIBA	2-5F1B

* PCT技術により製造されています。

Produced by Perfect Crystal Device Technology.

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	V_{CB}=120V, I_E=0	—	—	0.1	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	V_{EB}=5V , I_C=0	—	—	0.1	μA
直流電流増幅率 (Note)	h_{FE}	V_{CE}=6V , I_C=2mA	350	—	1200	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C=10mA , I_B=1mA	—	—	0.3	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	V_{CE}=6V , I_C=2mA	—	0.65	—	V
トランジション周波数	f_T	V_{CE}=6V , I_C=1mA	—	150	—	MHz
コレクタ出力容量	Cob	V_{CB}=10V , I_E=0 f = 1MHz	—	—	3.0	pF
雑音指数	NF	V_{CE}=6V , I_C=0.1mA R_g=10kΩ, f=10Hz			6.0	dB
		V_{CE}=6V , I_C=0.1mA R_g=10kΩ, f=1kHz			1.0	dB

Note ; h_{FE} により下表のように分類し，現品表示してあります。

According to the value of h_{FE}, the 2SC2088 is classified as follows.

CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SC2088−BL	350	700
2SC2088−V	600	1200